EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

63318173

PUBLICATION DATE

27-12-88

APPLICATION DATE

19-06-87

APPLICATION NUMBER

62152951

APPLICANT: NEW JAPAN RADIO CO LTD;

INVENTOR:

KOGA MASANOBU;

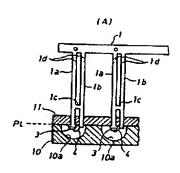
INT.CL.

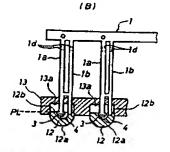
H01L 33/00 H01L 21/56

TITLE

MANUFACTURE OF OPTICAL

SEMICONDUCTOR DEVICE





LLUT AVAILABLE COPY

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the positioning of a pellet and a lens in precision and to strengthen the stem by a method wherein a semiconductor pellet is installed on a lead frame, wire-bonding is accomplished, and then a stem section and a lens section are formed in different injection molding processes.

CONSTITUTION: A light-emitting or photodetecting pellet 3 is installed on a lead pin 1a of a lead frame 1, and is wire-bonded to a lead pin 1b. Next, the lead pins 1a and 1b are clamped by a top force 11, a bottom force 10 is closed for the injection of a transparent resin into a recess 10a, and hardening follows for the formation of a lens section 12a. A process follows wherein the lead pins 1a and 1b are clamped by a split mold 13, resin is injected into a recess 13a, and the resin is hardened for the formation of a stem section. A thermal contact wire bonder may be used because pellet installation is completed prior to stem formation. Resins may be selected to suit the purposes best because a lens section and stem section are formed in different processes. Precision is quite high in positioning a pellet 13 and lens 12 because they are guided by lead pins.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-318173

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)12月27日

H 01 L 33/00 21/56 N-7733-5F J-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

の発明の名称 光半導体装置の製造方法

②特 願 昭62-152951

郊出 願 昭62(1987)6月19日

@発明者 雲然 國

埼玉県上福岡市福岡2丁目1番1号 新日本無線株式会社

川越製作所内

⑫発 明 者 古 賀 正 信

埼玉県上福岡市福岡2丁目1番1号 新日本無線株式会社

川越製作所内

⑪出 願 人 新日本無線株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目22番14号

邓代 理 人 弁理士 山 田 稔

明 細 舊

1. 発明の名称

光半導体装置の製造方法

2.特許請求の範囲

先ず、リードフレームの一方のリードピンの媼 面上に発光又は受光ペレットを搭載した後、味ペレットの所定電極部と他方のリードピンの媼面と を連組で接続する工程と、

搭載された缺ペレット及び接続された疎滞線を含めて透明樹脂材料を用いた射出成形法によって はペレットを中心とするレンズ部を形成する工程 と、

該レンズ部射出成形工程の前又は後において、 両リードピンのうち搭載された該ペレット及び接続された該導線を含まず該レンズ部に隣接すべき 部分に対し射出成形によってステム部を形成する T程と

を有することを特徴とする光半導体装置の製造 方法。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

木発明は、ステム部及びレンズ部を有する発光 ダイオード(LED)、フォトダイオードなどの 光半導体装置の製造方法に関し、特に、そのステム部及びレンズ部を共に射出成形法によって別工 程で成形する技術に関するものである。

【従来の技術】

ある。レンズ部6はペレット3に対する危光又は 受光の指向性ないし災光性を高めるものである が、ペレット3及び金属組織4を無止する機能も 備えている。この技、タイパー1c及びリードピン 切断部ldを切断して単体の光半導体装置が作成さ れる。かかる製造方法はポッティングモールド法 と呼ばれているが、他に往型モールド法が知られ ている。即ち、柱型モールド法は、第4図に示す ように、リードフレーム 1 の一方のリードピン1a の端面上に発光又は受光ペレット3を導電性ペー ストによって接続搭載し、そのペレット3の所定 運模部と他方のリードピンlbの端面とを金属組線 4 で接続する工程と、次に、特型保持具7にて リードフレーム1のピッチ毎に保持された離盟8 に充填した液状透明樹脂 9 に対し、リードフレー ム 1 のペレット 3 餌を挿入侵債し、高温乾燥によ り液状透明樹脂を硬化せしめ、雌型8に相当する ドーム状のレンズ部を含む外周器を形成した後、 雌型 8 より引き抜く工程を有するものである。そ の後、タイパーlc及びリードピン切断部ldを切断

熱膨張係数が異なるので、液状透明樹脂9の高温 乾燥時において両者間に寸法の食い違いを生じさ せることとなり、多数個取りの成形にあっては リードピン la . lbのピッチとレンズ部のピッチに ズレを蒸起させる。また、離型8内へ挿入する リードピン1a、1bの先端部についての位置挟め手 段を設けることができないので、ペレット3とレ ンズ部の中心とが合せずらい。更に、ステム部は 透明樹脂を以てレンズ部と一体的にそのまま形成 され、したがってステム部は圧力成形されていな いので、かかる点からして強度が不十分であるこ とは勿論、レンズ部は透明体であることが必要 で、樹脂強化のための充塡剤を混入することがで きないから、ステム部の強度は実用上不十分で、 リードピン1a、1a間の閉き加減によっては割れを 生じる場合がある。

[42 HI (0 EI 641]

本発明は、上記問題を解決するものであり、次 の事項を目的とする光半導体装置の製造方法を提 供することにある。

して単体の光半導体装置が作成される。

「解決すべき問頭占」

しかしながら、上記各製造方法にあっては次の 問題点がある。

①ポッティングモールド法にあっては、ステム部 2を形成した後で、金属細線4を接続するもので あり、ステム部2の構成樹脂の耐熱特性に限界が あるため、加熱温度の高い熱圧着ワイヤポンダを 使用することができず、超音波熱圧着併用ワイヤ ボンダか、超音波ワイヤボンダのみの使用を余儀 なくされている。また、液状透明樹脂材の滴下に よってレンズ部6を形成するものであるから、樹 脂の粘度、表面強力、重力などによって、 その 鏑 最の定員精度が出にくく、特に、多数個取りの場 合には時間差によって粘度が左右されるので、レ ンズ部6の寸法、形状にバラツキが現われる。 ②注型モールド法にあっては、ポッティングモー ルド法による場合に比し、レンズ部の寸法、形状

①ペレットの所定電極部と他のリードピンとを導 線で接続する場合、熱圧着ワイヤボンディング法

は一定となるが、リードフレーム1と折型保持具

7 とは目的機能が異なるため、同一材質でなく、

②ステム部を充分な強度で形成できること。

③レンズ部の寸法、形状が常に一定で、ペレット を中心にした配置のレンズ部を高精度に形成でき ること。

[問題点の解決手段]

も使用できること。

上記各目的をすべて達成するため、水発明に係 る光半導体装置の製造方法は、次の①~③の工程 を有するものである。

①先ず、リードフレームの一方のリードピンの端 面上に発光又は受光ペレットを搭載した後、該ペ レットの所定電極部と他方のリードピンの端面と を導線で接続する工程があること。

②搭載された鉄ペレット及び接続された鉄溝線を 含めて透明樹脂材料を用いた射出成形法によって **敲ペレットを中心とするレンズ部を形成する工程** があること。

③ 缺レンズ部射出成形工程の前又は後において、

両リードピンのうち格板された缺ペレット及び接続された被導線を含まず減レンズ部に降接すべき 部分に対し射出成形によってステム部を形成する 工程があること。

[作用]

かかる構成の光半導体装置の製造方法によれば、ステム部の成形以前にペレットの搭載及び導線の接続が行なわれるので、支障なく無圧着ワイヤボンディング法を用いることが可能であり、またステム部とレンズ部は夫々別の射出成形にせることから、夫々の機能を具有させると、強度の高いステム部を形成でき、した共にしているという。となるというで、シンズ部の中心になり、とので、レンズ部の中心になどとして高くいるので、レンズ部の中心になどを提供できるので、レンズ部の中心になどを提供できるので、レンズ部の中心になどを提供できる。

[実施例]

次に、本発明の実施例を添付図面に基づいて説明する。

状凹面10a 内に被状透明樹脂が射出され、その硬化によって第1図(B) に示す如くのレンズ部12が成形される。作成されたレンズ部12は下型10のドーム状凹面10a に沿う歪みなき凸面12a を有し、射出成形による圧縮力付与によって均一密度を保力する。また、割型の上型11を利用してリードピン1aを位置決めできるから、ベレット3をレンズ部12の中心に合せることができる。なお、パーティングラインPLはレンズ部の編面12b 縁部とその端面12b のうちリードピン1aを通る線上に形成されるが、レンズ部12の凸面12a には存在せず、光学的指向性などの支障にはならない。

次に、第1図(8) に示す如く、ステム部を形成すべき凹所 13a を有する割型 13でリードピン1a, lbをクランプしつつレンズ部 12の 端面 12b 近傍部に充塡剤を配入した被状樹脂を射出せしめ、その硬化によってステム部を成形する。ここで、レンズ部 12の 端部 12b 寄りは凹所 13a に一部嵌合されている。かかる工程によって充分な圧縮力付与及び充塡剤の混入によって、高い強度のステム部が

部1 図は、本発明に低る光半導体装置の製造方法の第1 実施例における各工程を示す拡大縦断而図である。

一対のリードピンla、lbを多数個有するリードフレーム 1 を用意し、一方のリードピンlaの協っに のまで 大口 で 発光 ストによって 発光 又は 受光 べい かっかる 金属 細線 4 で接続する。 かかる 金属 細線 4 で接続する。 かかる 金属 細線 4 で接続する。 かかまだ作成が のな は に ない ことから、 熱圧 若 ワイヤボンディング 法 を 自由に 用いる ことができる。

次に、素子部としての搭載されたペレット 3 及び接続された金属細線 4 を下型 10の ドーム状 凹前 10a 内に位置させると共に、割型の 上型 11でリードピン 1a. 1bの終端部を クランブしつつ下型 10a を閉じる。 かかる 状態に おいては、 リードピン 1a が下型 10の ドーム 状凹面 10a の中心を 迫るよう位置決めされる。この型合せが完了すると、ドーム

形成される。なお、この後、タイパー1c及びリードピン切断部1dを切断して単体の光半導体装置が作成される。

第2図は、本発明に係る光半導体装置の製造方法の第2実施例における各工程を示す拡大緩断而図である。

本実施例においても、第1実施例と同様に、まず、一方のリードピンlaの端面に海流性ペーストによって発光又は受光ペレット3を接続した後、そのペレット3の所定性極部(図示せず)と他方のリードピンlb端面とを無圧着ワイヤボンディング法などを以て金属細線4で接続する。

次に、第2図(A) に示す如く、ステム部形状の空間15a を有する割型15でペレット3及び金属組線 4 を避けたリードピン1a、1bの終端部をクランプしつつ、その空間15a 内へ充塡剤を混入させた液状樹脂を射出せしめ、その硬化によってステム部16が成形される。射出圧及び充塡剤の混入によって充分な強度のステム部16が得られる。

次に、第2図(B) に示す如く、下型17のドーム

[発明の効果]

以上説明したように、本発明に係る光半導体装置の製造方法は、リードピンの先端に発光又は受光ペレットを搭載した後、電極部を導線で接続し、しかる後、射出成形法によるステム部の成形とないずれか

レットの位置を高特度にレンズ部の中心に合致させることができる。加えて、各種レンズ形状などを比較的容易に成形でき、指向特性ないし受光特性の異なる高品質の光半導体装置を各種提供できる。

③リードピンを位置決め手段として利用できるから、多数個取りの射出成形の場合にあっても、各レンズ部及びステム部の寸法のくるいを抑制でき、歩留りの大幅向上を図ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図(A) 、(B) は、本発明に係る光半導体装置の製造方法の第 1 実施例における各工程を示す拡大縦断面図である。

第2図(A)。(B)は、本実施例に係る光半導体装置の製造方法の第2実施例における各工程を示す拡大縦断面図である。

第3 図は、従来の光半導体装置の製造方法に係るポッティングモールド法を示す拡大線断面図である。

第4回は、従来の別の光半導体装置の製造方法

一方を先にして別々に施す点に特徴を行するもの であるから、次の効果を奏する。

① ステム部成形前にペレット搭載及び導線按線工程があるから、ステム部に対する加熱温度上の制限がなく、熱圧着ワイヤボンディング法など各種のボンディング法を自由に用いることができ、固着強度などを強くできる。

のステム部及びレンズ部は独立した射出成形法により形成されるので、ステム部の成形においては充填剤の超入を行なうことができると共に、射出による強い圧縮力によってステム部の強度を充分高くすることができ、リードピンの開きや曲げによるステム部及びレンズ部の割れなどが発生せず、歩躍りの向上に客与する。

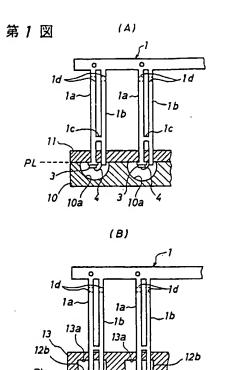
③また、レンズ部も射出成形法によって成形されるので、レンズ面を金型面通りの滑り面仕上げとすることができると共に、射出圧による判密なレンズ部を作成でき、ペレットに対する気密保護ないし耐湿性を一層高めることができる。更に、リードピンを金型で位置決めできることから、ペ

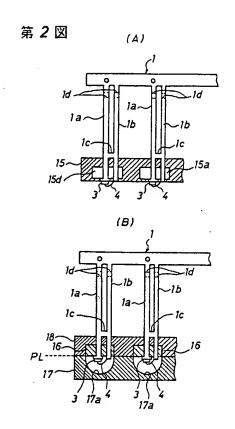
に係る注型モールド法を示す拡大緩断面図であ ス

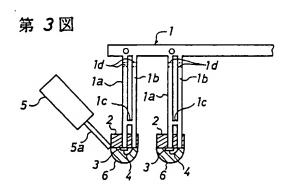
1 ・・・リードフレーム、1a.1b・・・リードピン、1c・・・タイパー、1d・・・リードピン切断部、3・・・発光又は受光ペレット、4・・・金属細線、10・・・ドーム状凹面、11・・・割型の上型、10a・・・レンズ部、12a・・・凸面、13・・・凹所を有する割型、13a・・・凹所、15・・・空間を有する割型、15a・・・空間、16・・・ステム部、17・・・ドーム状凹面を有する下型、17a・・・ドーム状凹面、18・・・割型の上型。

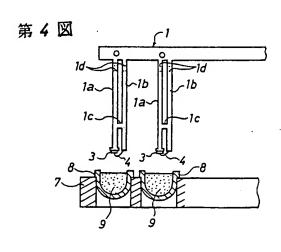
出願人 新日本無線株式会社

代理人弁理士 山田 &









This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
☐ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.